



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

SU (II) 1450098 A1

60 4 Н 03 К 5/24, Г 05 В 1/01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГННТ СССР

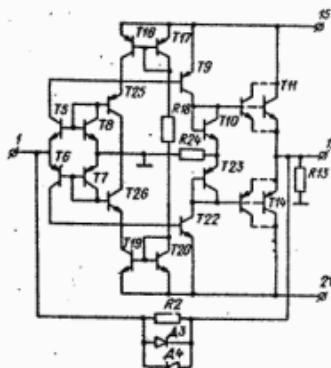
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 4204509/24-21
(22) 02.03.87
(46) 07.01.89. Бюл. № 1
(72) А.Д. Азаров, В.Я. Стейская,
Ю.М. Степаенко и М.И. Демин
(53) 621.374.33(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 1363452, кл. Н 03 К 5/24, 31.10.86.

(54) ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО СХЕМЫ СРАВНЕНИЯ ТОКОВ

(57) Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в аналого-цифровых преобразователях и цифровых измерительных приборах. Цель изобретения - повышение точности сравнения кодов - достигается за счет уменьшения напряжения сдвига и уменьшения потребляемой мощности.

При включении питания через резистор 18 и транзисторы (T) 17 и 20 в однодиодном включении протекает ток смещения. Так как коэффициент отражения токовых зеркал, выполненных на T 16, 17 и 19, 20, практически равен единице, то через T 16-19 протекает ток, равный тому смещению. Базовые токи T 25 и 26 в ϑ раз меньше этого тока и протекают через T 8, 7, являющиеся датчиками токовых зеркал на T 8, 5 и 7, 6 соответственно, коэффициент отражения которых равен единице. Схема предложенного устройства выполнена симметрично относительно шины нулевого потенциала, и в описании изобретения приводится работа в динамическом режиме только первой половины схемы предложенного устройства. 1 ил.



SU (II) 1450098 A1

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в аналогово-цифровых преобразователях и в цифровых измерительных приборах.

Цель изобретения - повышение точности сравнения токов за счет уменьшения напряжения сдвига и уменьшение потребляемой мощности.

На чертеже представлена принципиальная схема предлагаемого входного устройства схемы сравнения токов.

Входное устройство схемы сравнения токов содержит входную шину 1, которая подключена к первым выводам первого резистора 2 и двух встречно включенных диодов 3 и 4, эмиттеру первого 5 и эмиттеру второго 6 транзистора, база которого соединена с базой и коллектором третьего транзистора 7, эмиттер которого соединен с шиной нулевого потенциала и с эмиттером четвертого транзистора 8, коллектор и база которого соединены между собой и с базой первого транзистора 5, коллектор которого соединен с базой пятого транзистора 9, коллектор которого соединен с базой шестого транзистора 10 и с базами седьмого транзистора 11, состоящего из п параллельно включенных транзисторов, эмиттер которых соединены с выходной шиной 12, первым выводом второго резистора 13, второй вывод которого соединен с шиной нулевого потенциала, вторыми выводами первого резистора 2 и двух встречно включенных диодов 3, 4, эмиттерами восьмого транзистора 14, состоящего из п параллельно соединенных транзисторов, а коллекторы - с шиной 15 положительного питания, с эмиттерами десятого 16 и десятого 17 транзисторов, базы которых соединены между собой и подключены к коллектору десятого транзистора 17 и первым выводом третьего резистора 18, второй вывод которого соединен с базой одиннадцатого транзистора 19, коллектором и базой двенадцатого транзистора 20, эмиттер которого соединен с шиной 21 отрицательного питания, с эмиттером одиннадцатого транзистора 19 и коллекторами восьмого транзистора 14, базы которого соединены с коллектором тринадцатого транзистора 22 и базой четырнадцатого 23, эмиттер которого соединен с эмитте-

ром шестого транзистора 10, коллектор второго транзистора 6 соединен с базой тринадцатого транзистора 22, четвертый резистор 24 первым выводом соединен с эмиттерами шестого и четырнадцатого транзисторов 10 и 23, коллекторами которых соединены со своими базами, второй вывод четвертого резистора 24 соединен с шиной нулевого потенциала, с коллектором пятнадцатого 25 и коллектором шестнадцатого 26 транзисторов, база которого соединена с коллектором и базой третьего транзистора, а эмиттер - с коллектором одиннадцатого транзистора 19, база пятнадцатого транзистора 25 соединена с коллектором и базой четвертого транзистора 8, а эмиттер - с коллектором девятого транзистора 16, эмиттер пятого транзистора 9 соединен с шиной 15 положительного питания, а эмиттер тринадцатого транзистора 22 - с шиной 21 отрицательного питания.

Входное устройство схемы сравнения токов работает следующим образом.

При включении питания через резистор 18 и транзисторы 17 и 20, включенных диодном включении, протекает ток смещения I_{cm} , равный

$$I_{cm} = \frac{U_{ пит}^+ + U_{ пит}^- - U_{B3,17} - U_{B3,20}}{R18},$$

где $U_{ пит}^+$, $U_{ пит}^-$ - напряжение питания положительного и отрицательного источника питания, соответственно;

$U_{B3,17}$, $U_{B3,20}$ - напряжение база-эмиттер транзисторов 17 и 20;

$R18$ - значение резистора 18.

Так как коэффициент отражения токовых зеркал на транзисторах 16, 17 и 19, 20 практически равен единице, то через транзисторы 16-19 будет протекать ток, равный I_{cm} . Базовый ток транзисторов 25 и 26, в β раз меньший I_{cm} , протекает через транзисторы 8 и 7, являющиеся датчиками токовых зеркал на транзисторах 8, 5, 7 и 6 соответственно, коэффициент отражения которых равен единице. Выходной ток токовых зеркал является базовым током транзисторов 9 и 22. При согласованности транзисторов 26, 22, 25 и 9, 8

и 5, 6 и 7 выходной ток транзисторов 9 и 22 практически будет равен I_{cm} . Протекая через транзисторы 10 и 23 в диодном включении, являющиеся датчиками токовых зеркал на транзисторах 10, 11 и 23, 14 соответственно, через транзисторы 11 и 14 устанавливается ток, равный pI_{cm} . При идентичности параметров транзисторов прямой и обратной проводимости, при входном токе $\Delta I_{by} = 0$, на выходе предлагаемого устройства ΔI_{by} также бы был равен нулю. При использовании реальных транзисторов разных проводимостей, имеющих разброс, на резисторе 13 и резисторе $2dI_{by} \neq 0$ создает напряжение смещения $U_{cm} \neq 0$, уменьшающее точность сравнения токов.

Работа схемы в динамическом режиме происходит следующим образом. Учитывая, что схема симметрична относительно шины нулевого потенциала, рассмотрим работу только одной половины схемы, например нижней, при втекающем входном токе $I_b \neq 0$. В данном случае первый каскад на транзисторе 6, включенный по схеме с общей базой, что обеспечивает низкое входное сопротивление во всей полосе частот, создает усиление по току, равное α_6 , вторым усилительным каскадом является схема с общим эмиттером на транзисторе 22 с коэффициентом усиления по току, равным β_{22} . Третий каскадом усиления является токовое зеркало на транзисторах 23 и 14 с коэффициентом усиления по току $K_{T3,14}$, равным: $R24/R13$. При $R24 \ll K_{T3,14}$ равен β_4 .

Работа второй половины предлагаемого устройства аналогична рассматриваемой, только с противоположным по знаку приращением. Коэффициент усиления по току предлагаемого устройства $K_{T3,14}$ будет равен

$$K_{T3,14} = \frac{R24}{R13} \cdot \frac{\alpha_6 \cdot \beta_{23} + \alpha_5 \cdot \beta_3}{2},$$

где α_6 , α_5 - коэффициенты усиления по току транзисторов 6 и 5, соответственно;

β_{23} , β_3 - коэффициенты усиления по току транзисторов 23 и 9;

R_{24} , R_{13} - значения резисторов 24 и 13 соответственно.

Как видно из формулы коэффициента усиления предлагаемого устройства, резистор 24, называемый резистором масштаба, служит для уменьшения коэффициента усиления и расширения полосы пропускания входного устройства схемы сравнения токов.

Ф о р м у л а изобр ет ен и я

Входное устройство схемы сравнения токов, содержащее три резистора, 15 два диода, четырнадцать транзисторов, шину нулевого потенциала, шину положительного питания, шину отрицательного питания, выходную шину, подключенную к первым выводам первого резистора и двух встречно включенных диодов, эмиттеру первого и эмиттеру второго транзистора, база которого соединена с базой и коллектором третьего транзистора, эмиттер 20 которого соединен с шиной нулевого потенциала и с эмиттером четвертого транзистора, коллектор и база которого соединены между собой и с базой первого транзистора, коллектор которого соединен с базой пятого транзистора, коллектор которого соединен с базой шестого транзистора, состоящего из п параллельно включенных транзисторов, эмиттеры которых соединены с выходной шиной, первым выводом второго резистора, вторым выводом которого соединен с шиной нулевого потенциала, вторыми выводами первого резистора и двух встречно включенных диодов, эмиттерами восьмого транзистора, состоящего из п параллельно соединенных транзисторов, а коллекторы - с шиной положительного питания, с эмиттерами девятого и десятого транзисторов, базы которых соединены между собой и подключены к коллектору десятого транзистора и первому выводу третьего резистора, второй вывод которого соединен с базой одиннадцатого транзистора, коллектором и базой двенадцатого транзистора, эмиттер которого соединен с шиной отрицательного питания, с эмиттером одиннадцатого транзистора и коллекторами восьмого транзистора, базы которого соединены с коллектором тринадцатого транзистора и базой четырнадцатого, эмиттер которого соединен

иен с эмиттером шестого транзистора, а коллектор второго транзистора соединен с базой тринадцатого транзистора, отличающейся тем, что, с целью повышения точности сравнения токов и уменьшения потребляемой мощности, в него введены пятнадцатый и шестнадцатый транзисторы, четвертый резистор, который первым выводом соединен с эмиттерами шестого и четырнадцатого транзисторов, коллекторы которых соединены с базами своих транзисторов, второй вывод четвертого резистора соединен с шиной 15

5

10

15

нулевого потенциала, с коллектором пятнадцатого и коллектором шестнадцатого транзисторов, база которого соединена с коллектором третьего транзистора, а эмиттер - с коллектором одиннадцатого транзистора, при этом база пятнадцатого транзистора соединена с коллектором четвертого транзистора, а эмиттер - с коллектором девятого транзистора, эмиттер пятого транзистора соединен с шиной положительного питания, а эмиттер тринадцатого транзистора - с шиной отрицательного питания.

Редактор Г. Волкова

Составитель Н. Маркин

Техред М.Моргентал Корректор М.Максиминец

Заказ 6975/54

Тираж 929

Подписьное

ВНИИПО Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4